

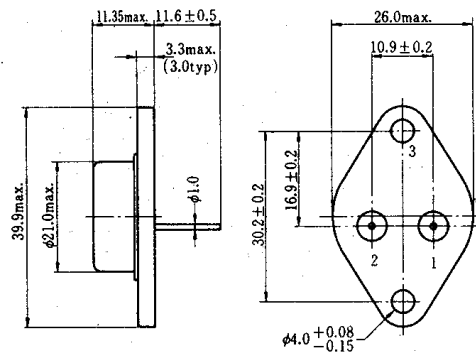
2SC3412

シリコン NPN 三重拡散形

TV 水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



(JEDEC TO-3)

1. ベース: Base
 2. エミッタ: Emitter
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

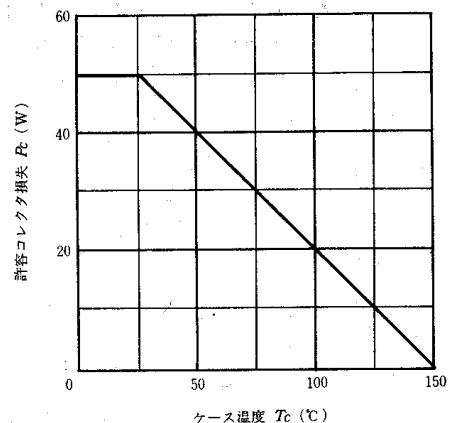
項目	Symbol	2SC3412	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	1300	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	500	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	8	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	10	A
許容コレクタ損失	P_C^*	50	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化

MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	500	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CES}	$V_{CE}=1,300\text{V}, R_{BE}=0$	—	—	0.5	mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{A}, I_B=1\text{A}^*$	—	—	5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=5\text{A}, I_B=1\text{A}^*$	—	—	1.5	V
蓄積時間	t_{stg}	$I_{cp}=5\text{A}, I_{B1}=1\text{A}$	—	3	—	μs
下降時間	t_f	$I_{cp}=5\text{A}, I_{B1}=1\text{A}$	—	0.2	—	μs

*パルス測定

* Pulse Test